

性能特点：

- 频率范围：100MHz~4GHz
- 插入损耗：0.7dB
- 输入回波损耗：14dB
- 输出回波损耗：14dB
- 隔离度：40dB
- 芯片尺寸：1.38mm×1.0mm×0.1mm

产品简介：

HH-SW200104 是一种 GaAs MMIC 正压吸收式单刀两掷开关芯片，该芯片在 100MHz~4GHz 频率范围内可提供小于 1dB 的插入损耗以及大于 38dB 的隔离度。HH-SW200104 采用+5V 供电。

电参数： (TA=25°C, VDD=+5V)

指标	最小值	典型值	最大值	单位
射频频率	0.1~4			GHz
插入损耗	-	0.7	1	dB
输入回波损耗	-	14	-	dB
输出回波损耗	-	14	-	dB
隔离度	38	40	-	dB
输入 P1dB	-	25	-	dBm

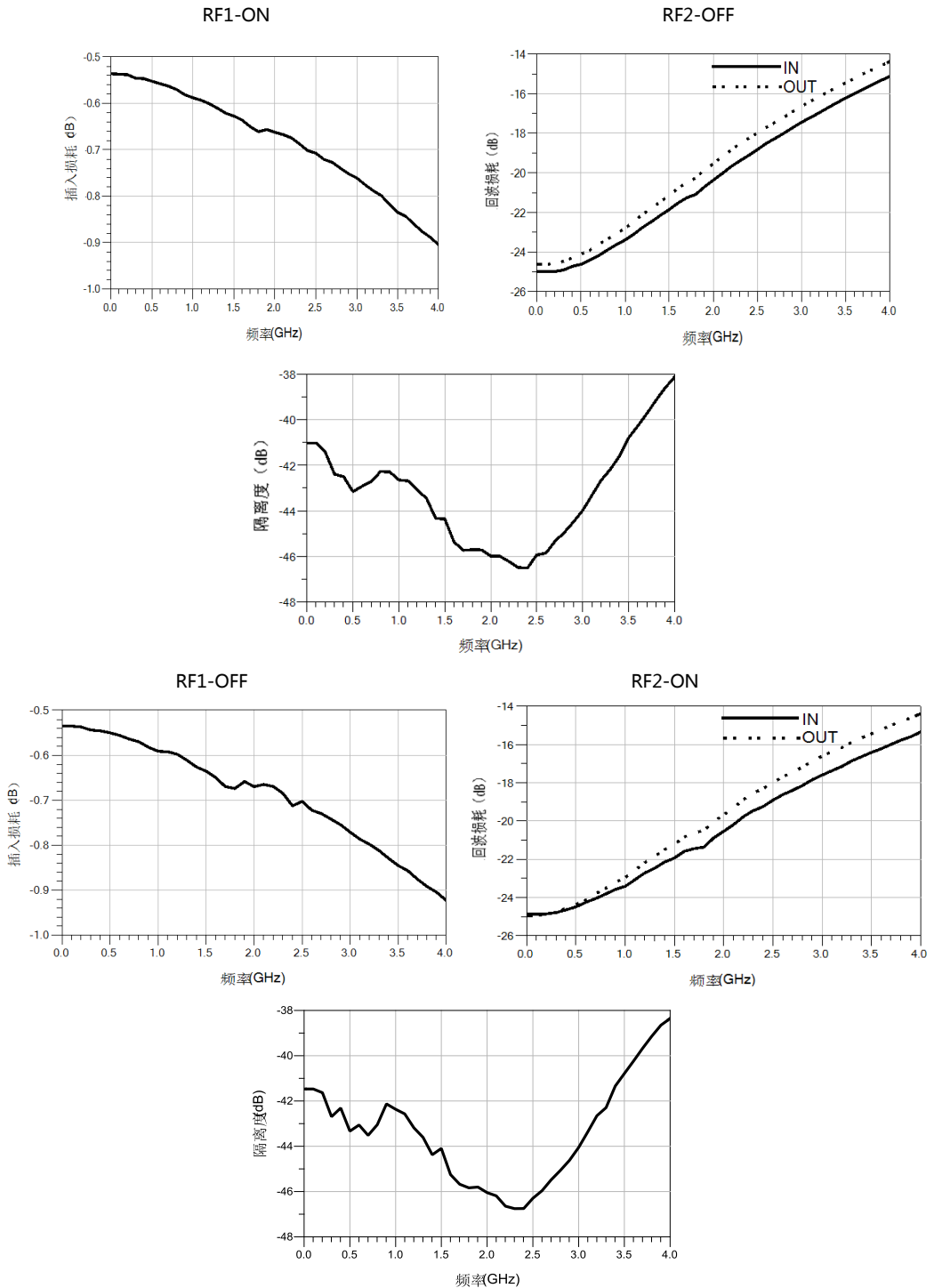
使用限制参数：

最大输入功率	30dBm
存储温度	-65°C~150°C
使用温度	-55°C~85°C

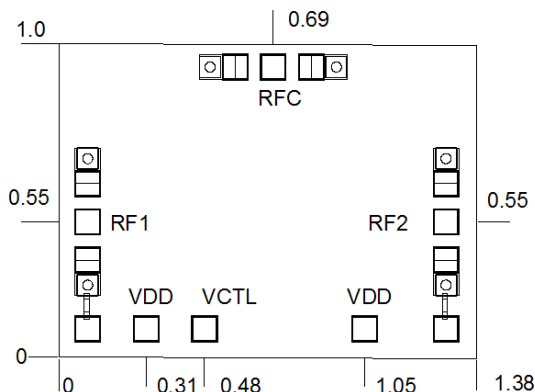
开关真值表：

VDD	VCTL	RF1	RF2
5	0	OFF	ON
5	5	ON	OFF

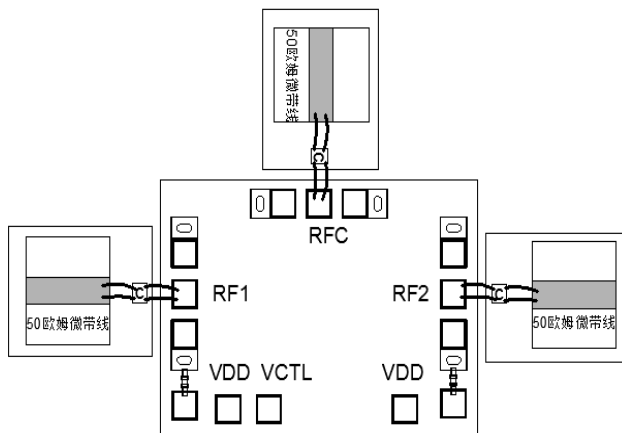
典型曲线：



尺寸图：(单位 mm)



建议装配图：



使用说明：

注意事项：输入输出无隔直电容，所有 C 电容值大小为 100PF。

存储：芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中，并在氮气环境下保存。

清洁处理：裸芯片必须在净化环境中操作使用，禁止采用液态清洁剂对芯片进行清洁处理。

静电防护：请严格遵守 ESD 防护要求，避免器件静电损伤。

常规操作：拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。

装架操作：芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶焊接或导电胶粘接工艺。安装面必须清洁平整。

键合操作：输入输出各用 2 根（建议直径 25um 金丝）键合线，键合线长度小于 250um 最优。建议采用尽可能小的超声波能量。键合时起始于芯片上的压点，终止于封装（或基板）。